

## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

## BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

## A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Trần Văn Quảng

2. Ngày tháng năm sinh: 05/08/1982; Nam ☒; Nữ ☐; Quốc tịch: Vietnam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☒

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 513b, tập thể E5, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): 3103 S2, Chung cư Seasons Avenue CT09,

Khu Cổ Ngựa, Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0945191492;

E-mail: tkuangv@gmail.com

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 2004 đến năm 2006: Giáo viên hợp đồng tại Khối chuyên Vật lý, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

Từ năm 2009 đến năm 2014: Nghiên cứu sinh tại Đại Học Ajou

Từ năm 2014 đến năm 2015: Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Viện nghiên cứu khoa học tự nhiên, Đại Học Sookmyung, Hàn Quốc.

Từ năm 2016 đến năm 2020: Cán bộ nghiên cứu hợp đồng hợp tác nghiên cứu tại Trường Đại Học Duy Tân

Chức vụ: Hiện nay: Giảng viên chính; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên chính

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

Địa chỉ cơ quan: Số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 0243 7664050

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 06 năm 2004, ngành: Sư phạm Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Khoa sư phạm (Nay là Trường Đại học Giáo dục), Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS ngày 16 tháng 03 năm 2007, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng TS ngày 14 tháng 08 năm 2014, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại Học Ajou, Hàn Quốc

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Giao thông Vận tải

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

***Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu các tính chất của vật liệu, trong đó tập trung chủ yếu vào nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng, tính chất nhiệt điện và tính chất từ của vật liệu khối và màng mỏng.***

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);

- Đã hoàn thành 1 đề tài NCKH cấp Bộ; 3 đề tài NCKH cấp Cơ sở;

- Đã công bố (số lượng) 27 bài báo KH, trong đó 9 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng 0 tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

| TT | Tên khen thưởng              | Cấp khen thưởng                   | Năm khen thưởng |
|----|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1  | Gương mặt trẻ tiêu biểu      | Đại Học Quốc Gia Hà Nội           | 2003            |
| 2  | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | 2016            |

|   |                                                        |                                   |      |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 3 | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở                             | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | 2017 |
| 4 | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở                             | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | 2018 |
| 5 | Giấy khen Hiệu trưởng                                  | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | 2018 |
| 6 | Đóng góp trong phong trào thi Olympic Vật lý toàn quốc | Hội vật lý Việt Nam               | 2019 |
| 7 | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở                             | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | 2019 |
| 8 | Bằng khen Bộ Trưởng                                    | Bộ Giáo Dục Đào Tạo               | 2019 |

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

| TT       | Tên kỷ luật | Cấp ra quyết định | Số quyết định | Thời hạn hiệu lực |
|----------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Không có |             |                   |               |                   |

## B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

***Phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Luôn có ý thức cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục. Luôn khách quan trong đào tạo. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo. Luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. Không ngừng học tập rèn luyện để hoàn thiện bản thân, phục vụ công tác giảng dạy và NCKH trong nhà trường. Luôn có ý thức nỗ lực đóng góp phát triển trường Đại Học Giao Thông Vận tải thông qua các hoạt động giảng dạy và hướng dẫn sinh viên NCKH với các vấn đề có tính thời sự, thực tiễn gắn với nhà trường.***

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên \*:

- Tổng số 12 năm.

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

| TT             | Năm học   | Số lượng NCS đã hướng dẫn |     | Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn | Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD | Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp |     | Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức |
|----------------|-----------|---------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|                |           | Chính                     | Phụ |                                    |                                         | ĐH                                        | SĐH |                                                            |
| 1              | 2008-2009 |                           |     |                                    |                                         | 320                                       |     | 320/696.1/280                                              |
| 2              | 2015-2016 |                           |     |                                    |                                         | 595                                       |     | 595/929/270                                                |
| 3              | 2016-2017 |                           |     |                                    |                                         | 390                                       |     | 390/560/270                                                |
| 3 năm học cuối |           |                           |     |                                    |                                         |                                           |     |                                                            |
| 4              | 2017-2018 |                           |     | 1                                  |                                         | 300                                       |     | 300/460.9/270                                              |
| 5              | 2018-2019 |                           |     | 1                                  |                                         | 345                                       |     | 345/604.7/270                                              |
| 6              | 2019-2020 |                           |     | 1                                  |                                         | 330                                       |     | 330/330/270                                                |

(\*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

### 3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☒:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☒ hoặc TSKH ☐; Tại nước: Hàn Quốc năm 2014

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☒:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): (1) Trường Đại Học Sookmyung, Hàn Quốc (Chuyên đề: Physics of

thermoelectric and magneto-electric effects: First-principles calculation) (2) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Giảng dạy Vật lý bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến của trường)

d) Đối tượng khác ☒; Diễn giải: Chứng nhận nghiên cứu sau tiến sỹ tại Hàn Quốc; Đọc hiểu các bài báo và các tài liệu chuyên môn; viết các bài báo chuyên môn; trình bày, thảo luận báo cáo tại các hội nghị Quốc tế tổ chức trong nước và quốc tế.

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng tiến sỹ và chứng nhận Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Hàn Quốc; Thư xác nhận giảng chuyên đề tại Hàn Quốc; chứng nhận hoạt động khoa học tại ICTP, Italy; Giấy mời tham dự các hội nghị Quốc tế ở ngoài nước.

4. Hướng dẫn NCS, học viên CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

| TT | Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT | Đối tượng |               | Trách nhiệm hướng dẫn |     | Thời gian hướng dẫn từ ... đến ... | Cơ sở đào tạo                 | Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                               | NCS       | HVCH/CK2/BSNT | Chính                 | Phụ |                                    |                               |                                                       |
| 1  | Đinh Thị Mến                  |           | X             | X                     |     | 12/2017 đến 12/2018                | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 2018                                                  |



|                               |                                           |    |                                 |   |    |                                                |                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----|---------------------------------|---|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | Phương pháp Giải Bài Tập Vật lý Đại Cương | TK | Nhà Xuất Bản Thế Giới, năm 2007 | 3 | VC | (Từ tr.143-tr.228; và từ tr.355-tr.410;)       | GPXB: 595-2007/CXB/2-176/thG                                                                 |
| Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ |                                           |    |                                 |   |    |                                                |                                                                                              |
| 2                             | Vật lý                                    | GT | Giao Thông Vận Tải, năm 2016    | 4 | VC | (Viết chương 4 và 5 Từ trang 70 đến trang 117) | Giáo trình trong trường ĐHGTVT ISBN: 978-604-76-0743-3 Quyết định số: 101/QĐ-GTVT 28/10/2015 |

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 0

*Lưu ý:*

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

**Các chữ viết tắt:** CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

| TT                              | Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)   | CN/PCN/TK | Mã số và cấp quản lý   | Thời gian thực hiện     | Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ |                                                  |           |                        |                         |                                                   |
| 1                               | Gần đúng eikonal trong lý thuyết trường lượng tử | CN        | T2007-CB-67, cấp Cơ sở | 1/1/2007 đến 31/12/2007 | 24-9-2007/<br>Tốt                                 |

| Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                          |                         |                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 1                             | Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài | CN | 103.01-2015.11, cấp Bộ   | 1/5/2016 đến 30/4/2018  | 04-2018/Đạt    |
| 2                             | Nghiên cứu sự phụ thuộc của cấu trúc mạng và tính chất nhiệt điện vào áp suất bằng phương pháp FLAPW trong lý thuyết phiếm hàm mật độ và lý thuyết Boltzmann                                                                                 | CN | T2016-KHCB-62, cấp Cơ sở | 1/1/2016 đến 31/12/2016 | 17-10-2016/Tốt |
| 3                             | Tác dụng của nén tinh thể lên tính chất vật lý của tinh thể hợp kim nano silicon-germanium pha tạp                                                                                                                                           | TK | T2018-CB-003, cấp Cơ sở  | 1/1/2018 đến 31/12/2018 | 12-12-2018     |

*Lưu ý:*

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

**Các chữ viết tắt:** CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

| TT                              | Tên bài báo/báo cáo KH                                                                                                   | Số tác giả | Là tác giả chính | Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN                                               | Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi) | Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn) | Tập, số, trang     | Năm công bố |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ |                                                                                                                          |            |                  |                                                                                               |                                                   |                                            |                    |             |
| 1                               | Spin dynamics of antiferromagnetic heisenberg systems on the triangular lattice with a strict single site occupation     | 3          | Có               | Communications in Physics/ISSN: 0868-3166                                                     |                                                   |                                            | 19 , 2, 71-76      | 2009        |
| 2                               | Temperature and carrier-concentration dependences of the thermoelectric properties of bismuth selenide dioxide compounds | 3          | Có               | Journal of the Korean Physical Society/ ISSN: 0374-4884 (print); ISSN: 1976-8524 (electronic) | Q3 - SCI<br><b>IF: 0.6</b>                        | 18                                         | 61 , 10, 1728-1731 | 2012        |

|   |                                                                                                                                                                   |   |    |                                                                                              |                            |   |                    |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|------|
| 3 | Electronic structure and magneto-optical properties of Co <sub>2</sub> MnX alloys where X = Ge, Sn and Pb: a first-principles investigation in the LDA+U approach | 3 | Có | Journal of the Korean Physical Society ISSN: 0374-4884 (print); ISSN: 1976-8524 (electronic) | Q3 - SCI<br><b>IF: 0.6</b> | 4 | 62 , 12, 2184–2187 | 2013 |
| 4 | Spin-orbit Coupling Effect on the Structural Optimization; Bismuth Telluride in First-principles                                                                  | 2 | Có | Journal of The Korean Magnetics Society/ ISSN (Print): 1598-5385; ISSN (Online): 2233-6648   | - ESCI                     |   | 23 , 1, 23/(1):1-6 | 2013 |
| 5 | The metal-insulator phase transition in the strained GdBiTe <sub>3</sub>                                                                                          | 2 | Có | Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979; e-ISSN: 1089-7550                               | Q1 - SCI<br><b>IF: 2.3</b> |   | 113 , 17A934       | 2013 |
| 6 | Effect on the Electronic, Magnetic and Thermoelectric Properties of Bi <sub>2</sub> Te <sub>3</sub> by the Cerium Substitution                                    | 2 | Có | IEEE Transactions on Magnetics/ISSN: 0018-9464                                               | Q2 - SCI<br><b>IF: 1.7</b> | 4 | 50 , 1, 1000904    | 2014 |

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

|    |                                                                                                                                     |   |       |                                                                                              |                            |   |               |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---------------|------|
| 7  | Ứng dụng trạng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu trạng thái nền của SbBiTe <sub>3</sub>                                         | 1 | Có    | Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải /ISSN: 1859-2724                                         |                            |   | N/A , 48, 65  | 2015 |
| 8  | Nanocrystal growth of single-phase Si <sub>1-x</sub> Gex alloys                                                                     | 5 | Không | Journal of Physics and Chemistry of Solids/ISSN: 0022-3697                                   | Q2<br><b>IF: 2.8</b>       | 8 | 93, 121-125   | 2016 |
| 9  | Electronic Structures and Thermoelectric Properties of Layered Chalcogenide PbBi <sub>4</sub> Te <sub>7</sub> from First-Principles | 2 | Có    | Journal of the Korean Physical Society/ISSN: 0374-4884 (print); ISSN: 1976-8524 (electronic) | Q3 - SCI<br><b>IF: 0.6</b> | 3 | 68 , 393-397  | 2016 |
| 10 | First-principles Study on the Magnetic Properties of Gd doped Bismuth-Telluride                                                     | 2 | Có    | Journal of The Korean Magnetics Society /ISSN (Print): 1598-5385; ISSN (Online) 2233-6648    | - ESCI                     |   | 26(2) , 39-44 | 2016 |
| 11 | Về đặc trưng cấu trúc tinh thể và trạng thái nền của một số vật liệu trong tính toán lý thuyết                                      | 1 | Có    | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên /ISSN: 2354-0575          |                            |   | 11, 69-73     | 2016 |

|    |                                                                                                   |   |    |                                                                                                    |                            |    |                 |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----------------|------|
| 12 | Role of O and Se defects in the thermoelectric properties of bismuth oxide selenide               | 2 | Có | Journal of Applied Physics/ISSN: 0021-8979; e-ISSN:1089-7550                                       | Q1 - SCI<br><b>IF: 2.3</b> | 10 | 120 ,<br>195105 | 2016 |
| 13 | Tuning the Electronic Structure of Si1-xGex Alloys                                                | 3 | Có | VNU Journal of Science: Mathematics – Physics /ISSN: 2615-9341 e-ISSN:2588-1124                    |                            |    | 32 , 4, 57-62   | 2016 |
| 14 | Enhancement of the thermoelectric performance of oxygen substituted bismuth telluride             | 2 | Có | Journal of Applied Physics/ISSN: 0021-8979; e-ISSN: 1089-7550                                      | Q2 - SCI<br><b>IF: 2.3</b> | 4  | 122 ,<br>245104 | 2017 |
| 15 | Hiệu ứng nhiệt điện trên vật liệu bán dẫn n-type tạo thành từ thay thế pb trong bismuth telluride | 3 | Có | Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017/ISBN: 978-604-95-0326-9 |                            |    | , 798-801       | 2017 |
| 16 | Electronic structure and thermoelectric properties of Bi2Se3 under oxygen substitution            | 2 | Có | Science Journal of Metropolitan University /ISSN: 2354-1504                                        |                            |    | 20, 93          | 2017 |

|    |                                                                                                                          |   |       |                                                                                                               |  |  |                   |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------|
| 17 | Tính thể nano đơn pha Si1-xGex trong tính toán lý thuyết phiếm hàm mật độ sử dụng gần đúng mật độ địa phương             | 4 | Có    | Tạp chí Khoa Học Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2/ISSN: 1859-2325                                              |  |  | 53,               | 2018 |
| 18 | Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu sự hình thành tinh thể nano hợp kim Si-Ge                                  | 5 | Không | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội /ISSN: 2354-1083                               |  |  | 124,              | 2018 |
| 19 | Discussion on thermoelectric economy and research of bismuth telluride                                                   | 2 | Có    | Hanoi Metropolitan university: Scientific Journal/ISSN: 2354-1504                                             |  |  | N/A , 24, 89      | 2018 |
| 20 | Optimal carrier concentration for high thermoelectric performance of lead substituted bismuth telluride in p-type doping | 1 | Có    | Communication in Physics /ISSN: 0868-3166                                                                     |  |  | 28 , 02, 169-177  | 2018 |
| 21 | Về giới hạn trên của hệ số phẩm chất nhiệt điện không thứ nguyên của Bi <sub>2</sub> Te <sub>3</sub>                     | 1 | Có    | Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (spms 2019)/ISBN: 978-604-98-7505-2 |  |  | Quyển 1 , 211-214 | 2019 |

|    |                                                                                                                                                               |   |    |                                                                                                               |                            |  |                   |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|------|
| 22 | Bàn về cấu trúc vùng năng lượng của Si và Ge với các ô cơ sở siêu mạng, Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (spms 2019) | 1 | Có | Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (spms 2019)/ISBN: 978-604-98-7505-2 |                            |  | Quyển 1 , 206-210 | 2019 |
| 23 | Effect of external static electric field on some properties of iron thin film                                                                                 | 2 | Có | Hanoi Metropolitan university: Scientific Journal/ISSN: 2354-1504                                             |                            |  | N/A , 35, 54      | 2019 |
| 24 | Temperature and carrier concentration dependence of thermoelectric properties of GeBi <sub>4</sub> Te <sub>7</sub>                                            | 2 | Có | Journal of the Korean Physical Society/ ISSN: 0374-4884 (print); ISSN: 1976-8524 (electronic)                 | Q3 - SCI<br><b>IF: 0.6</b> |  | 74 , 3, 256-260   | 2019 |
| 25 | Electrically controlled magnetism in iron thin film                                                                                                           | 1 | Có | IOP conference Series/ISSN: 1742-6588; e-ISSN: 1742-6596                                                      | - Scopus                   |  | 1506 , 012009     | 2020 |
| 26 | Electronic Thermal Conductivity and Thermoelectric Performance of PbBi <sub>4</sub> Te <sub>7</sub> (Accepted)                                                | 1 | Có | VNU Journal of Science: Mathematics - Physics /ISSN: 2615-9341                                                |                            |  | [Accepted]        | 2020 |

|    |                                                                                                                        |   |    |                                           |  |  |                    |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------|--|--|--------------------|------|
| 27 | Valance band maximum and thermoelectric properties of Bi <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Se: first-principles calculations | 1 | Có | Communication in Physics /ISSN: 0868-3166 |  |  | 30 , 5, [Accepted] | 2020 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------|--|--|--------------------|------|

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà U'V là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 4

*Lưu ý:* Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS. 7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

| TT       | Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích | Tên cơ quan cấp | Ngày tháng năm cấp | Tác giả chính/ đồng tác giả | Số tác giả |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| Không có |                                                |                 |                    |                             |            |

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

| TT       | Tên giải thưởng | Cơ quan/tổ chức ra quyết định | Số quyết định và ngày, tháng, năm | Số tác giả |
|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Không có |                 |                               |                                   |            |

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

| TT       | Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích | Cơ quan/tổ chức công nhận | Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm) | Cấp quốc gia/Quốc tế | Số tác giả |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|
| Không có |                                     |                           |                                          |                      |            |

- Trong đó, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

| TT       | Chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ | Vai trò | Cơ sở giáo dục đại học |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Không có |                                                                                |         |                        |

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín\*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UỶ chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UỶ chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UỶ chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UỶ chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UỶ không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UỶ không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

**(\*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.**

### **C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:**

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Người đăng ký  
(Ký và ghi rõ họ tên)

